

低周波電力増幅用
シリコンPNPエピタキシャルプレーナ形

概 要

2SB529は、シリコン樹脂封止形のシリコンPNPエヒタキシャルプレーナ形パワートランジスタで、コレクタ損失は5W(100×100×2mmアルミニウム放熱板つき、周囲温度25℃)、コレクタ電流は-2Aです。大電流での直流電流増幅率の低下が非常に少ないので、低歪率の出力が得られ、カーステレオ等の出力用として、2SD359とコンプリメンタリで使用するのに最適です。

特 長

- 大電流での h_{FE} の低下が非常に少ない
- コレクタ電流が大きい($I_C = -2A$ 、 $I_{CM} = -3A$)
- Knee特性が良い($V_{CE} \leq -1V$)

用途

- カーステレオ、カーラジオ、テープレコーダ等の3～10W出力
の低周波電力増幅回路

最大定格($T_c=25^{\circ}\text{C}$)

記 号	項 目	定 格 値	単 位
V _{CB0}	コレクタ・ベース間電圧	—40	V
V _{EB0}	エミッタ・ベース間電圧	—5	V
V _{CE0}	コレクタ・エミッタ間電圧	—20	V
I _C	コレクタ電流	—2	A
I _{CM}	ぜん頭コレクタ電流	—3	A
P _C	コレクタ損失	T _a = 25℃	W
P _C		T _C = 25℃	W
T _J	接合部温度		150℃
T _{stg}	保存温度		—55 ~ +150℃

電氣的特性($T_c=25^{\circ}\text{C}$)

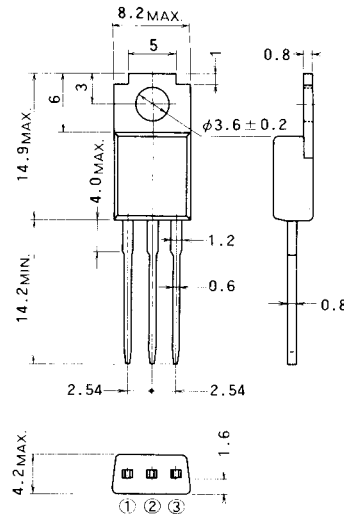
記 号	項 目	測 定 条 件	特 性 値			単 位
			最 小	標 準	最 大	
V(BR)CBO	コレクタ・ベース降伏電圧	$I_C = -1\text{mA}, I_E = 0$	-40			V
V(BR)EBO	エミッタ・ベース降伏電圧	$I_E = -1\text{mA}, I_C = 0$	-5			V
V(BR)CEO	コレクタ・エミッタ降伏電圧	$I_C = -10\text{mA}, R_{BE} = \infty$	-20			V
ICBO	コレクタしや断電流	$V_{CB} = -25\text{V}, I_E = 0$			-1	μA
IEBO	エミッタしや断電流	$V_{EB} = -5\text{V}, I_C = 0$			-1	μA
$h_{FE} \uparrow$	直流電流増幅率	$V_{CE} = -4\text{V}, I_C = -0.5\text{A}$, パルス測定	55	110	300	
V _{CE}	コレクタ・エミッタ間電圧	$I_C = -1.5\text{A}, I_B = -0.05\text{A}$			-1	V
V _{BE}	ベース・エミッタ間電圧	$V_{CE} = -4\text{V}, I_B = -0.05\text{A}$		-0.7		V

†: h_{FE} の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

アイテム	C	D	E
h _{FE}	55～110	90～180	150～300

外形図

單位：mm



電極接続

- ①：ベース EIAJ：—
②：コレクタ(放熱板) JEDEC：—
③：エミッタ

(注1) 公差指定のない寸法は代表値を示す。